



## 500mA、推挽式变压器驱动器， 用于隔离电源设计

### 概述

MAX258是500mA、推挽式、变压器驱动器，为隔离电源提供简单的解决方案。IC具有内部振荡器，采用+3.0V至+5.5V单电源供电。利用变压器副边与原边的匝数比设定输出电压，可以产生任意电压的隔离输出。

器件内部集成振荡器，驱动一对n沟道功率开关。内部电路确保工作在固定的50%占空比，保证不会有直流电流通过变压器。

IC连续工作电流为500mA，具有欠压锁定和热关断。

IC提供低电流关断模式，禁用驱动器时将总电源电流降至5µA (最大)以下。

MAX258采用小尺寸8引脚(2mm x 3mm) TDFN封装，工作在-40°C至+125°C温度范围。

### 特性和优势

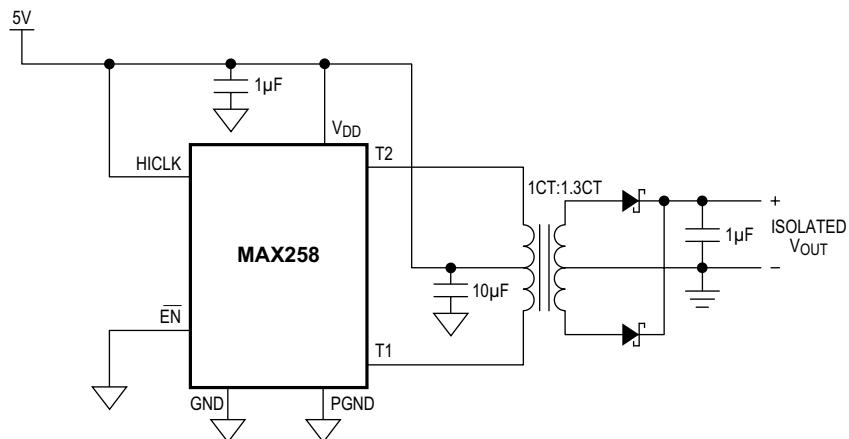
- 简单灵活的设计
  - +3.0V至+5.5V供电范围
  - 低R<sub>ON</sub>，4.5V时300mΩ (最大)
  - 效率高达90%
  - 提供高达500mA的变压器驱动
  - 250kHz或600kHz内部振荡器频率
  - -40°C至+125°C工作温度范围
- 集成系统保护
  - 欠压锁定
  - 热关断
- 节省电路板空间
  - 小尺寸8引脚TDFN封装(2mm x 3mm)

### 应用

- 电表数据接口
- 隔离现场总线接口
- 医疗装置
- 隔离模拟前端

定购信息在数据资料的最后给出。

### 典型工作电路



相关型号以及配合该器件使用的推荐产品，请参见：[china.maximintegrated.com/MAX258.related](http://china.maximintegrated.com/MAX258.related)。

# 500mA、推挽式变压器驱动器， 用于隔离电源设计

## Absolute Maximum Ratings

(All voltages referenced to GND.)

$V_{DD}$ , HICLK, $\bar{EN}$	-0.3V to +6V
T1, T2	-0.3V to +16.5V
T1, T2 Maximum Continuous Current	+1.75A
Continuous Power Dissipation ( $T_A = +70^\circ\text{C}$ )	
TDFN (Multilayer Board)	-40°C to +125°C
(derate 16.7mW/°C above +70°C)	+150°C
Continuous Power Dissipation ( $T_A = +70^\circ\text{C}$ )	+1.75A
TDFN (Multilayer Board)	-65°C to +150°C
(derate 16.7mW/°C above +70°C)	+300°C
Continuous Power Dissipation ( $T_A = +70^\circ\text{C}$ )	+1333.3mW

Operating Temperature Range	-40°C to +125°C
Junction Temperature	+150°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s)	+300°C
Soldering Temperature (reflow)	+260°C

## Package Thermal Characteristics (Note 1)

TDFN (Multilayer)

Junction-to-Ambient Thermal Resistance ( $\theta_{JA}$ )	60°C/W
Junction-to-Case Thermal Resistance ( $\theta_{JC}$ )	11°C/W

**Note 1:** Package thermal resistances were obtained using the method described in JEDEC specification JESD51-7, using a four-layer board. For detailed information on package thermal considerations, refer to [china.maximintegrated.com/thermal-tutorial](http://china.maximintegrated.com/thermal-tutorial).

*Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.*

## Electrical Characteristics

( $V_{DD} = +3.0\text{V}$  to  $5.5\text{V}$ ,  $T_A = T_{MIN}$  to  $T_{MAX}$ , unless otherwise noted. Typical values at  $V_{DD} = +5.0\text{V}$  and  $T_A = +25^\circ\text{C}$ .) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
<b>DC CHARACTERISTICS</b>						
Supply Voltage Range	$V_{DD}$		3.0	5.5		V
Supply Current	$I_{DD}$	$V_{\bar{EN}} = 0\text{V}$ , T1 and T2 not connected	$V_{HICLK} = 0\text{V}$	1.1	1.8	mA
			$V_{HICLK} = V_{DD}$	2.1	3.5	
Disable Supply Current	$I_{DIS}$	$V_{\bar{EN}} = V_{DD}$ , T1, T2, HICLK connected to GND or $V_{DD}$ (Note 3)		5		µA
Driver Output Resistance	$R_O$	$I_{OUT} = 500\text{mA}$	$V_{DD} = 3.0\text{V}$	160	350	mΩ
			$V_{DD} = 4.5\text{V}$	145	300	
Undervoltage Lockout Threshold	$V_{UVLO}$	$V_{DD}$ rising	2.6	2.75	2.9	V
Undervoltage Lockout Threshold Hysteresis	$V_{UVLO\_HYST}$			250		mV
T1, T2 Leakage Current	$I_{LKG}$	$V_{\bar{EN}} = V_{DD}$ , T1, T2 = 0V or $V_{DD}$	-1	+1		µA
<b>LOGIC SIGNALS (<math>\bar{EN}</math>, HICLK)</b>						
Input Logic-High Voltage	$V_{IH}$		2			V
Input Logic-Low Voltage	$V_{IL}$			0.8		V
Input Leakage Current	$I_{IL}$	$\bar{EN}$ , HICLK = 0V or 5.5V	-1	+1		µA

# 500mA、推挽式变压器驱动器， 用于隔离电源设计

## Electrical Characteristics (continued)

( $V_{DD} = +3.0V$  to  $5.5V$ ,  $T_A = T_{MIN}$  to  $T_{MAX}$ , unless otherwise noted. Typical values at  $V_{DD} = +5.0V$  and  $T_A = +25^{\circ}C$ .) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
<b>AC CHARACTERISTICS</b>						
Switching Frequency	$f_{SW}$	Figure 1	$V_{HICLK} = 0V$	237	250	263
			$V_{HICLK} = V_{DD}$	564	600	636
T1, T2 Duty Cycle	D			50		
T1, T2 Slew Rate	$t_{SLEW}$	Figure 1			200	V/ $\mu$ s
Crossover Dead Time	$t_{DEAD}$	Figure 1			50	ns
<b>PROTECTION</b>						
Thermal-Shutdown Threshold	$T_{SHDN}$			+160		
Thermal-Shutdown Hysteresis	$T_{SHDN\_HYS}$			30		

Note 2: All units are 100% production tested at  $T_A = +25^{\circ}C$ . Specifications over temperature are guaranteed by design.

Note 3: Disable supply current includes output-switch-leakage currents.

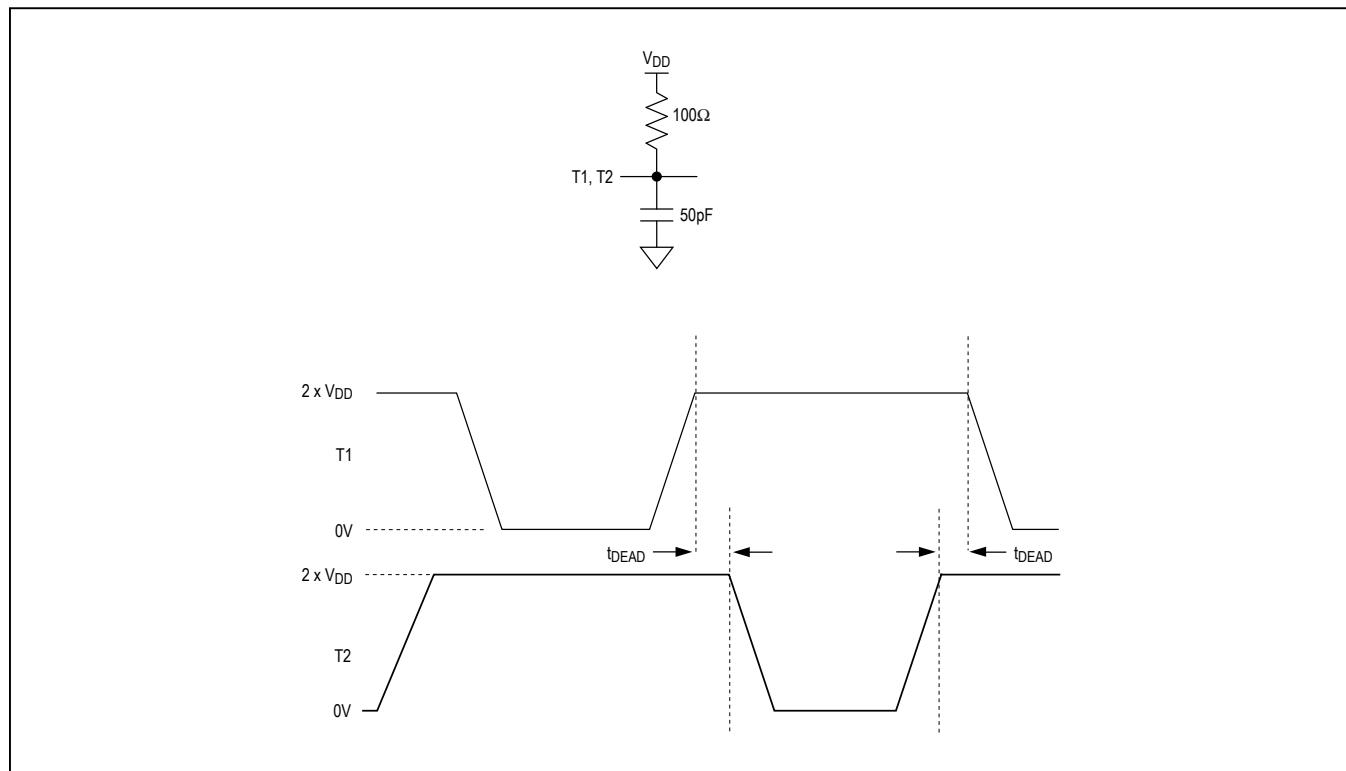
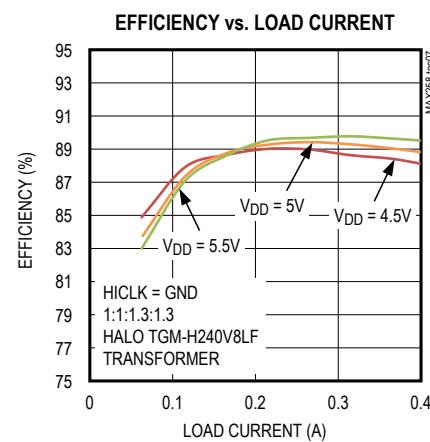
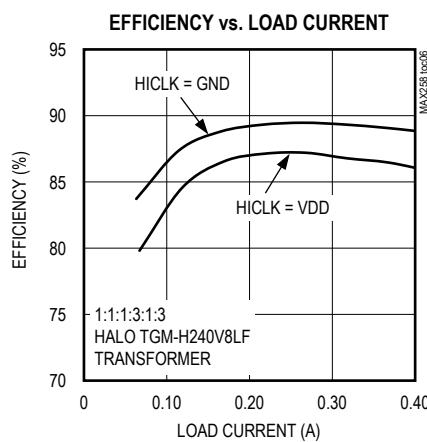
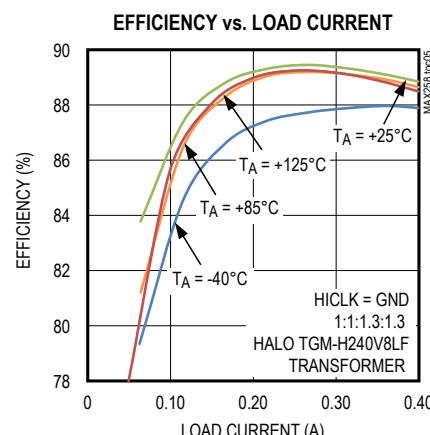
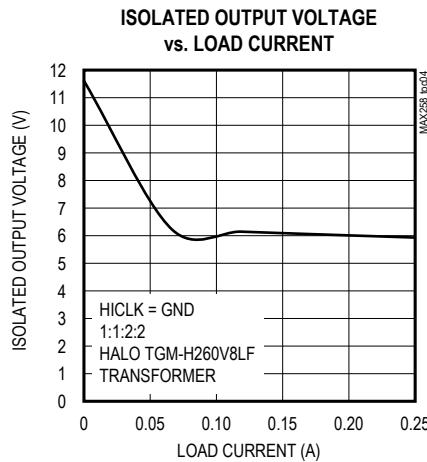
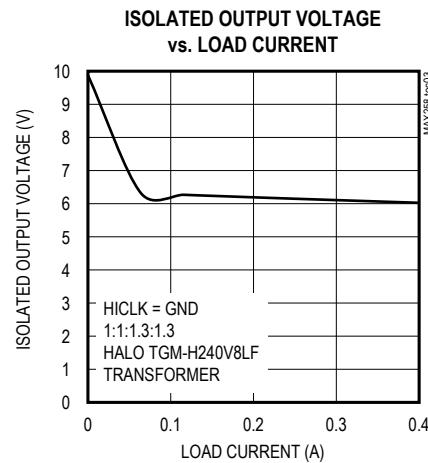
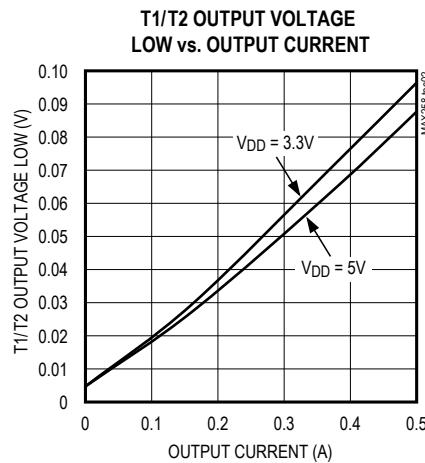
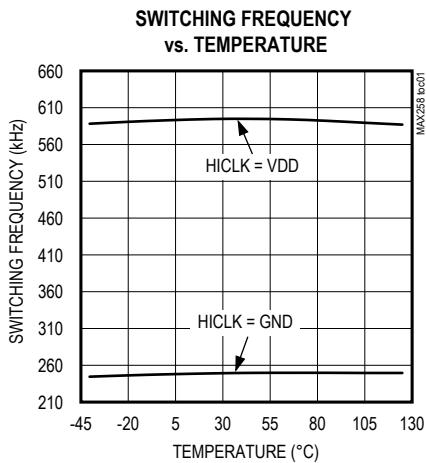


图1. T1、T2时序图

# 500mA、推挽式变压器驱动器， 用于隔离电源设计

## 典型工作特性

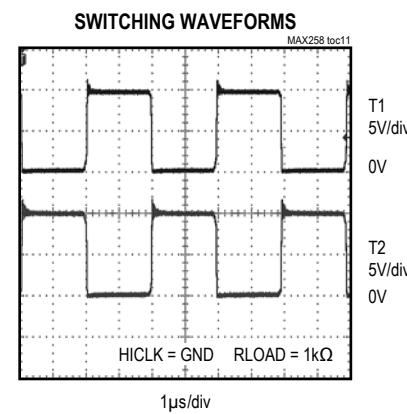
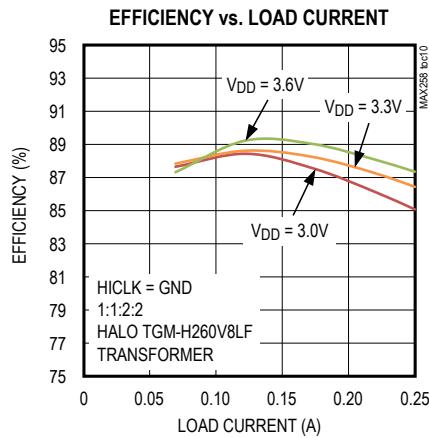
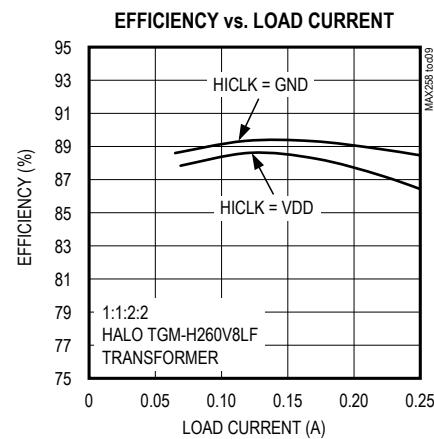
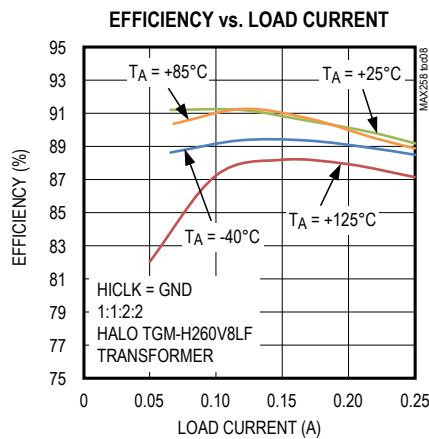
( $V_{DD} = +5V$ ,  $T_A = +25^\circ C$ , unless otherwise noted.)



## 500mA、推挽式变压器驱动器， 用于隔离电源设计

### 典型工作特性(续)

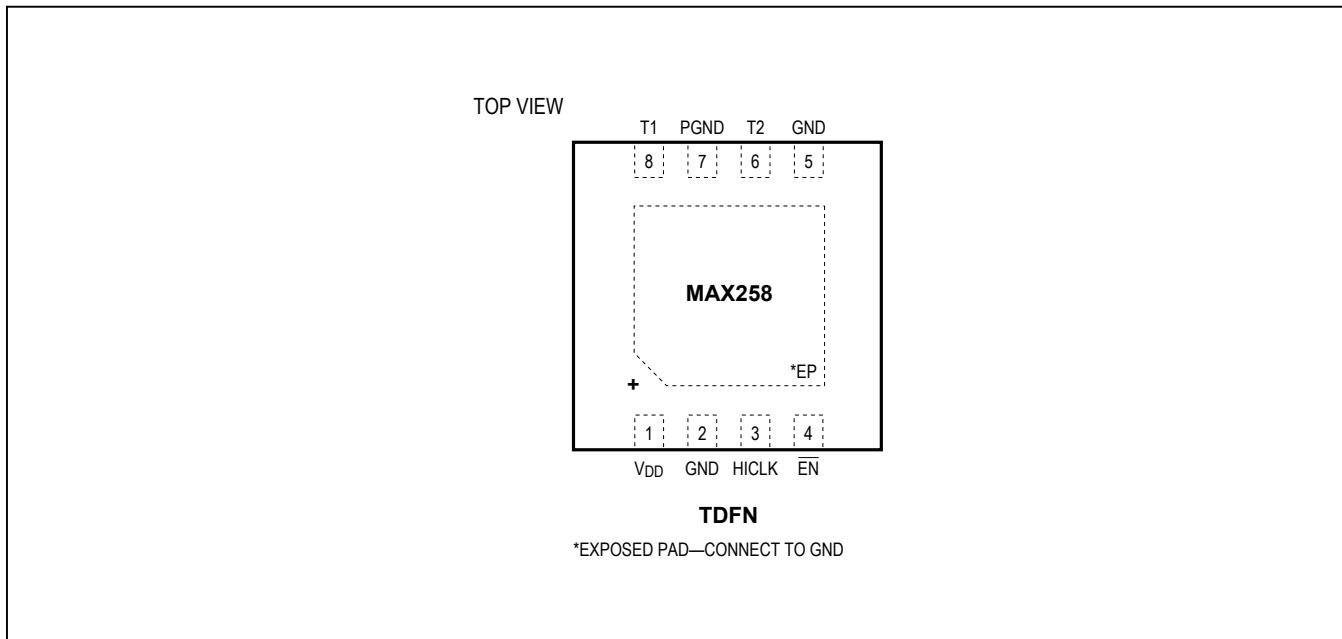
( $V_{DD} = +5V$ ,  $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ , unless otherwise noted.)



# MAX258

## 500mA、推挽式变压器驱动器， 用于隔离电源设计

### 引脚配置

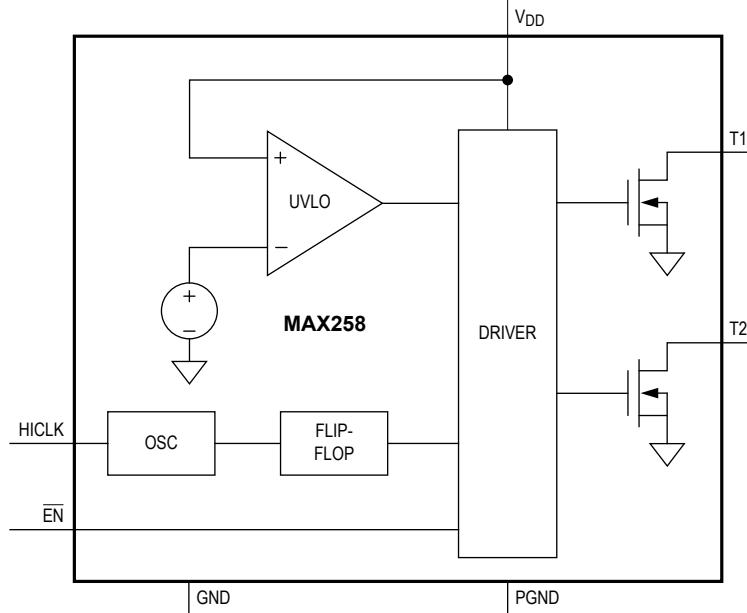


### 引脚说明

引脚	名称	功能
1	V <sub>DD</sub>	电源输入，利用1μF电容将V <sub>DD</sub> 旁路至GND，电容尽量靠近器件放置。
2, 5	GND	逻辑电路地和模拟地。
3	HICLK	内部振荡器频率选择输入。HICLK为高电平时，将内部振荡器的开关频率设置为600kHz；HICLK为低电平时，将内部振荡器的开关频率设置为250kHz。
4	EN	低电平有效使能输入。EN为低电平时使能器件，EN为高电平时禁止器件。
6	T2	变压器驱动输出2。
7	PGND	电源地。变压器原边电流流经PGND，确保对地为低阻连接。
8	T1	变压器驱动输出1。
—	EP	裸焊盘，内部连接至GND。将EP连接至大的接地区域，以增强散热；裸焊盘不作为电气连接点。

# 500mA、推挽式变压器驱动器， 用于隔离电源设计

## 功能框图



## 详细说明

MAX258为集成原边变压器驱动器，用于隔离电源设计。器件内置振荡器和MOSFET，为中心抽头变压器的原边绕组提供高达500mA驱动电流。IC具有内部振荡器，支持自主工作模式。内部触发器保证占空比固定在50%，避免直流电流流入变压器。

器件工作在+3.0V至+5.5V单电源，带有用于控制启动的欠压锁定。热关断电路提供额外的热保护。

## 隔离电源应用

器件允许配合各种副边整流电路工作(见图2)。通过选择原边与副边匝数比调节隔离输出电压。器件工作在最高+5.5V的输入电源时，能够为变压器原边提供高达500mA的电流驱动。

## 内部振荡器

器件带有内部振荡器，保证占空比为50%。HICLK输入为高电平时，将内部振荡器频率设置为600kHz (典型值)；HICLK输入为低电平时，将内部振荡器频率设置为250kHz (典型值)。

## 摆率控制

T1和T2驱动器具有摆率控制，以限制EMI。

## 禁止模式

器件包括引脚可选的禁用模式，以降低功耗。禁止模式下，器件耗流小于5µA (最大)，此时T1和T2输出高阻态。

## 上电和欠压锁定

IC提供欠压锁定，既确保受控的上电状态，又可防止在振荡器稳定之前启动开关工作。上电及正常工作期间，如果电源电压下降到VUVLO以下，欠压锁定电路将强制器件进入禁止模式。禁止模式下，T1和T2输出高阻态。

## 500mA、推挽式变压器驱动器， 用于隔离电源设计

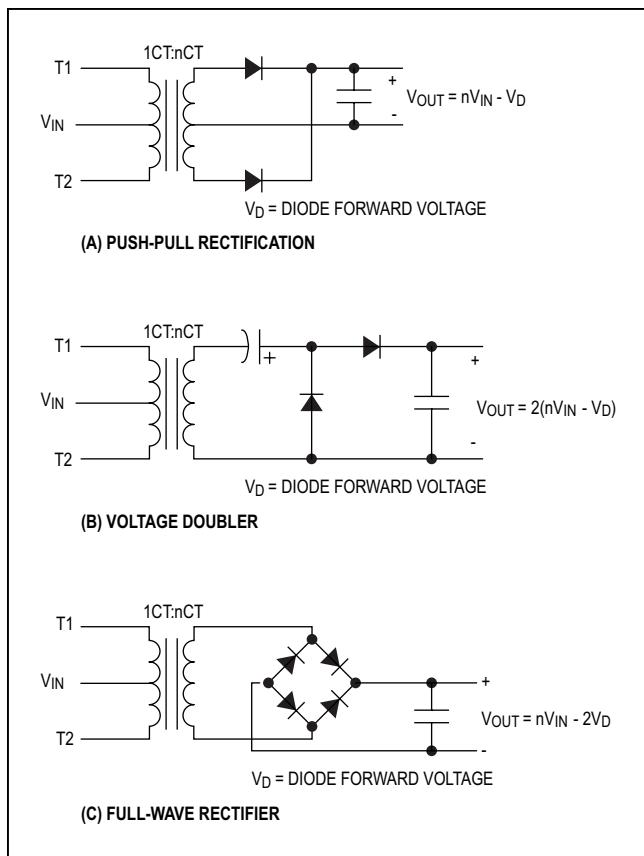


图2 .副边整流拓扑

### 热关断

器件集成热关断保护电路，防止热损坏。结温( $T_J$ )超过 $+160^{\circ}\text{C}$  (典型值)时，关闭器件； $T_J$ 降至 $+130^{\circ}\text{C}$  (典型值)以下时，器件恢复正常工作。

### 应用信息

#### 功耗

器件功耗由下式估算：

$$P_D = (R_O \times |I_{PRI}|^2) + (I_{DD} \times V_{DD})$$

式中， $R_O$ 为内部FET驱动器的电阻， $|I_{PRI}|$ 为流入T1和T2的负载电流。确保MAX258的功耗低于*Absolute Maximum Ratings*列出的数值，以正常工作。

#### 高温工作

器件工作在高温环境时，封装功耗会使结温上升到接近热关断状态。这种温度条件下，应保持足够低的功耗，使结温保留一定的安全裕量。最高结温应保持在 $+140^{\circ}\text{C}$ 以下。根据封装的热阻计算结温。

#### 电源去耦

利用 $1\mu\text{F}$ 陶瓷电容将 $V_{DD}$ 旁路至地，电容尽量靠近器件放置。

在 $V_{DD}$ 和地之间连接至少 $10\mu\text{F}$ 电容，电容尽量靠近变压器的原边中心抽头放置。该电容有助于稳定电源电压，保护IC不受 $V_{DD}$ 上较大电压尖峰的损害。

#### 输出稳压

对于多数应用，未经稳压的电路输出即可满足电源电压容限要求。这种配置下器件可以达到最高效率。变压器副边负载电流较小时，输出电压会大幅增大。为保护下行电路，电路工作在低负载条件时，需要限制输出电压。如果最小输出负载电流小于 $5\text{mA}$ 左右，需要在整流器输出节点和地之间连接一个齐纳二极管，将输出电压限制在安全范围。

对于需要稳压输出的应用，Maxim提供多种解决方案。下例中，假设输入电压容限为 $\pm 10\%$ 。

#### 例1：5V隔离，6V非稳压输出

图3所示电路中，MAX258用于产生隔离的5V输出。最小输入电压为5V时，整流器的输出电压大约为6V。

#### 例2：3.3V隔离，稳压至5V

图4所示的电路中，MAX8881低压差线性稳压器将隔离输出电压稳定在5V。利用一个1:2中心抽头变压器对来自3.3V输入的副边电压进行升压。最小输入电压为3.3V时，整流器的输出电压大约为6V。

# 500mA、推挽式变压器驱动器， 用于隔离电源设计

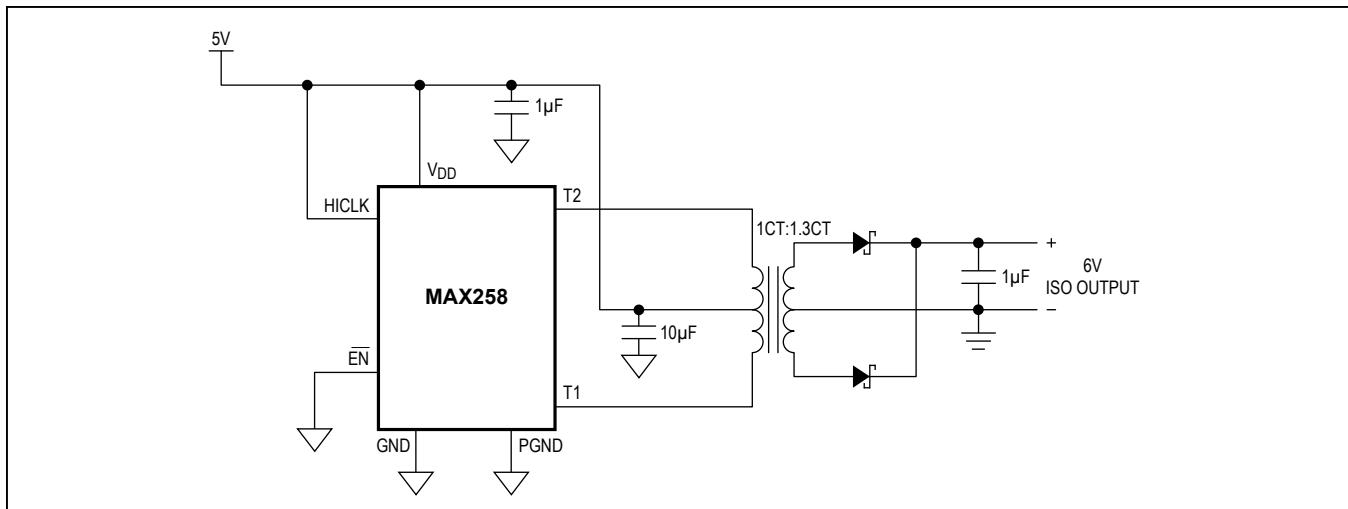


图3. 5V隔离, 6V非稳压输出应用电路

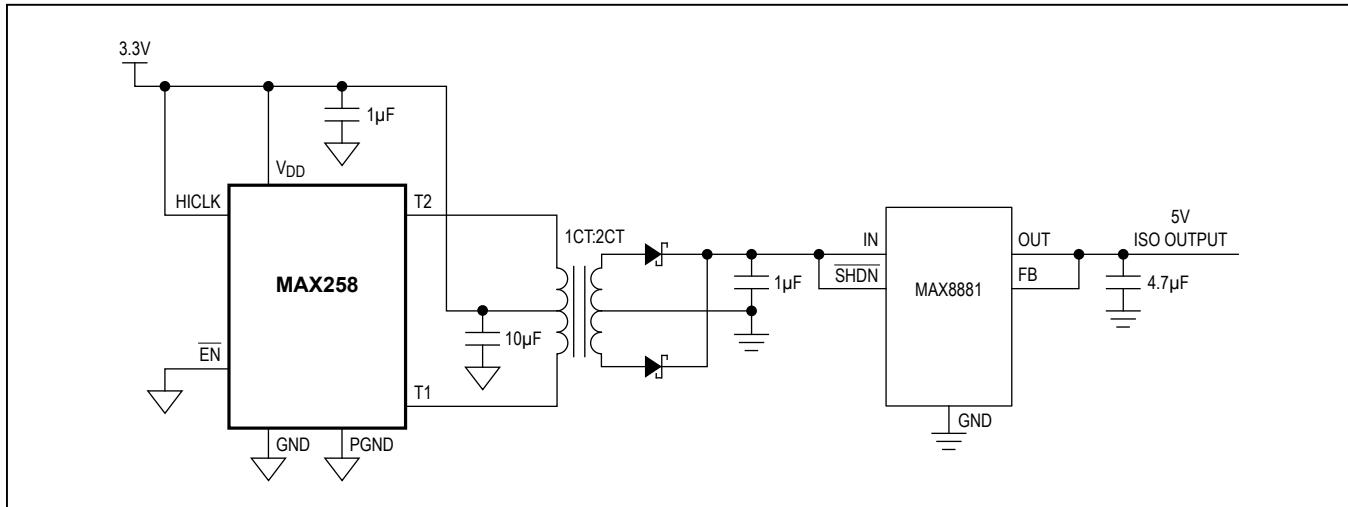


图4. 3.3V隔离, 5V稳压输出应用电路

## PCB布局指南

与所有电源电路一样, PCB布局对于获得低开关损耗和稳定工作至关重要。为了改善散热, 将裸焊盘连接至覆铜接地区域。

T1和T2至变压器的走线必须为低阻、低电感通路。变压器尽量靠近MAX258放置, 采用短而宽的走线。

如果可能, 使用一个电源区域将所有VDD连接至MAX258和变压器原边。如果接地区域不可用, 为避免损坏IC, 确

保流经变压器原边中心抽头的电流不通过连接MAX258电源引脚和VDD的相同走线, 使用超低电感的连线连接原边中心抽头与VDD电源。

## 裸焊盘

为优化热性能, 确保裸焊盘与接地区域的连接具有超低热阻。如果不能提供与地之间的低热阻通路, 大功率下可能造成结温过高。

## 500mA、推挽式变压器驱动器， 用于隔离电源设计

### 元件选择

#### 变压器选择

利用ET乘积，很容易为MAX258选择变压器。ET乘积将变压器磁芯所允许的最大磁通密度与绕组电压和开关周期联系在一起。器件工作在开关状态时，原边的电感电流随时间线性变化。尽管变压器的数据资料通常没有给出这样的参数，但每个变压器都存在最小ET乘积。确保与器件一起使用的变压器的每半个原边绕组的ET至少为： $ET = V_{DD}/(2 \times f_{SW})$ ，其中 $f_{SW}$ 为T1和T2输出的最小开关频率。

对于原边绕组，选择ET乘积足以满足条件的变压器，确保变压器工作时不会饱和。磁饱和会造成原边电感显著下降，进而大幅增大电流。

例如，且HICLK为低电平时，对于 $V_{DD}(\max) = 5.5V$ 的应用，要求对中心抽头的变压器ET乘积为 $13.1V\cdot\mu s$ 。对于 $V_{DD}(\max) = 3.3V$ 的应用，要求对中心抽头的变压器ET乘积为 $17.3V\cdot\mu s$ 。

除了ET乘积限制，需选择具有低漏感和低直流电阻绕线的变压器。铜损引起的变压器功耗估算如下：

$$P_{D\_TX} = I_{LOAD}^2 \times (R_{PRI}/N^2 + R_{SEC})$$

式中， $R_{PRI}$ 为原边的直流绕组电阻， $R_{SEC}$ 为副边的直流绕组阻抗。大多数应用中， $R_{SEC} = R_{PRI}/N^2$ 时达到最优。此时，原边和副边功耗相等。

与所有电源设计一样，优化电源效率非常重要。在采用小变压器的设计中，散热成为制约变压器效率的因素。变压

器损耗造成温度升高，从而降低了变压器的工作效率。而低效工作又进一步造成温度升高。

为确保变压器在任何工作条件下均满足这些要求，设计时应着重考虑最差工作条件。对于ET乘积最严格的要求体现在最大输入电压、最低开关频率和最高温度及负载电流条件下。此外，还要考虑最差工作条件下的变压器损耗和整流器损耗。

原边必须为中心抽头，但副边可以是或不是中心抽头，取决于所用的整流器拓扑。原边和副边绕组之间的相位无关紧要。

所设置的变压器匝数比必须能够在最小预计输入电压、最大预计负载条件下提供所要求的输出电压。此外，计算时还要考虑最差工作条件下的整流器损耗。由于按这种方式确定的匝数比在高输入电压和/或轻载条件下通常会在副边产生非常高的电压，所以要注意预防发生过压。

配合IC使用的变压器一般具有高磁导率磁芯。为最小化电磁辐射，选择环形、弧形磁芯、E/I/U磁芯，或类似磁芯。

#### 二极管选择

MAX258的高开关频率要求使用高速整流器。常规的硅信号二极管，例如1N914或1N4148，可用于低输出电流(小于50mA)应用；但当输出电流较大时，其反向恢复时间可能会影响工作效率。输出电流较高时，应选择具有低正向偏压的肖特基二极管，以改善效率。确保整流二极管的平均正向电流额定值大于电路的最大负载电流。对于表贴器件，推荐使用肖特基二极管，例如B230A、MBRS230和MBRS320。

### 推荐外部元件制造商

表1. 推荐外部元件制造商

MANUFACTURER	COMPONENT	WEBSITE
Halo Electronics	Transformers	<a href="http://www.haloelectronics.com">www.haloelectronics.com</a>
Diodes Inc.	Diodes	<a href="http://www.diodes.com">www.diodes.com</a>
Murata Americas	Capacitors	<a href="http://www.murataamericas.com">www.murataamericas.com</a>

# MAX258

## 500mA、推挽式变压器驱动器， 用于隔离电源设计

### 定购信息

器件	温度范围	引脚-封装
MAX258ATA+	-40°C至+125°C	8 TDFN-EP*

+表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装。

\*EP = 裸焊盘。

### 封装信息

如需最近的封装外形信息和焊盘布局(占位面积)，请查询[china.maximintegrated.com/packages](#)。请注意，封装编码中的“+”、“#”或“-”仅表示RoHS状态。封装图中可能包含不同的尾缀字符，但封装图只与封装有关，与RoHS状态无关。

封装类型	封装编码	外形编号	焊盘布局编号
8 TDFN-EP	T823+1	<a href="#">21-0174</a>	<a href="#">90-0091</a>

### 芯片信息

PROCESS: BiCMOS

# MAX258

## 500mA、推挽式变压器驱动器， 用于隔离电源设计

### 修订历史

修订号	修订日期	说明	修改页
0	5/13	最初版本。	—

### Maxim北京办事处

北京8328信箱 邮政编码100083

免费电话：800 810 0310

电话：010-6211 5199

传真：010-6211 5299



Maxim不对Maxim产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利许可。Maxim保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。电气特性表中列出的参数值(最小值和最大值)均经过设计验证，数据资料其它章节引用的参数值供设计人员参考。

**Maxim Integrated 160 Rio Robles, San Jose, CA 95134 USA 1-408-601-10 00**

© 2013 Maxim Integrated

12  
Maxim标志和Maxim Integrated是Maxim Integrated Products, Inc.的商标。